ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫЕ ПЛЕНКИ С ЗАМЕЩАЮЩИМИ ИОНАМИ

М.В. РУДЕНКО, Н.В. ГАПОНЕНКО

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ул. П. Бровки, 6, г. Минск, 220013, Республика Беларусь

Кристаллические соединения, обладающие структурой перовскита, находят широкое практическое применение в опто- и микроэлектронике благодаря ряду ценных свойств: сегнето- и антисегнетоэлектрики, ферромагнетики и др. В частности, больщой интерес представляет сегнетоэлектрик танталат стронция висмута (ТСВ) как перспективный материал для элементов энергонезависимой памяти.

Ключевые слова: перовскиты, золь-гель метод, танталат стронция висмута.

Сегнетоэлектрическая фаза танталата стронция висмута $Bi_2SrTa_2O_9$ формируется из аморфного танталата стронция висмута выше пороговой температуры [1], после чего TCB имеет слоистую структуру Ауривилиуса с расположенными друг за другом перовскитными блоками $(SrTa_2O_7)^{-2}$ и двумерными слоями $(Bi_2O_2)^{2+}$ [2, 3]. Наличие спонтанной поляризации делает данные сегнетоэлектрики ключевым материалом устройств энергонезависимой памяти. Введение редкоземельных элементов [4] позволяет получить люминесценцию в синем диапазоне. Таким образом, представлявляется целесообразным исследование структурных возможностей соединения и развитие методики их синтеза.

В данной работе пленки ТСВ получали золь-гель методом. Для синтеза золей использовали этоксид тантала ($Ta(OC_2H_5)_5$) и уксуснокислые соли стронция ($SrCH_3COO$) и одноосновного висмута ($BiOCH_3COO$). В качестве стабилизатора в золи добавляли ацетон. Время, в течение которого золь является пригодным для использования, составляет 1 неделю, после чего образуется желеподобный гель. Золи наносили методом центрифугирования со скоростью 2700 об/мин на подложки монокристаллического кремния. После нанесения каждого слоя образцы подвергались термообработке при температуре $200~^{0}$ С в течение 10-20~ мин. Затем следовала окончательная термообработка в течение 40~ минут при температуре $700~^{0}$ С.

На рис. 1 представлены изображения пленок ксерогеля $(Sr_xBi_y)Bi_2Ta_2O_9$ с избыточной концентрацией висмута 15%, полученного из золя (a, δ) и жидкого геля (ϵ, ϵ) , толщина пленок соответственно составляет 140 нм и 318 нм.

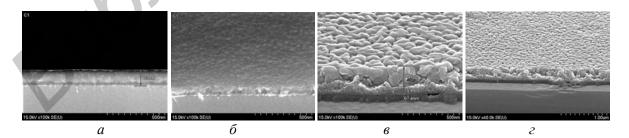


Рис. 1. РЭМ-изображения поверхности и скола пленок ксерогеля $(Sr_xBi_y)Bi_2Ta_2O_9$, полученного из золя (a, δ) и жидкого геля (a, δ)

На дифрактограммах (рис. 2, 3) отмечены отчетливые линии кристаллической фазы образцов, соответствующие соединению ($Sr_{0.82}Bi_{0.12}$) $Bi_2Ta_2O_9$ (PDF 00-089-6491).

Кристаллическая решетка имеет орторомбическую структуру с параметрами элементарной ячейки a = 5.51415, Å b = 5.51415, Å c = 25.0322 Å.

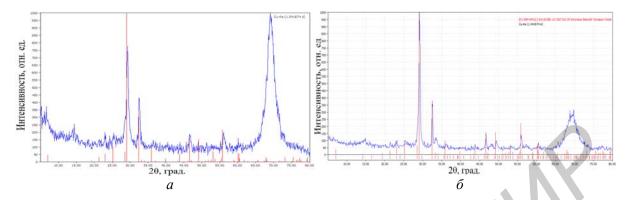


Рис. 2. Дифрактограмма пленок ксерогеля $(Sr_xBi_y)Bi_2Ta_2O_9$, полученного из золя (*a*) и жидкого геля (*б*)

При уменьшении избыточной концентрации висмута до 5% кристаллическая структура получаемого ксерогеля соответствуюет фазе $Bi_2SrTa_2O_9$ (PDF 00-049-0609). Кристаллическая решетка имеет орторомбическую структуру с параметрами элементарной ячейки a = 5.5274 Å, b = 5.5374 Å, c = 24.9914 Å.

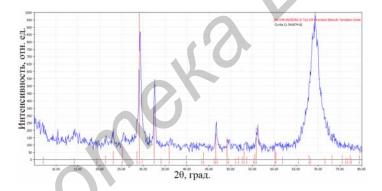


Рис. 3. Дифрактограмма пленки ксерогеля Bi₂SrTa₂O₉

Разработанная нами методика золь-гель синтеза позволяет получать пленки танталата стронция висмута $Bi_2SrTa_2O_9$ из уксуснокислых солей стронция и висмута. Продолжаются исследования зависимости фазового состава от концентрации висмута в соединении.

Список литературы

- 1. Housei Akazawa, Hiroshi Ando // J. Appl. Phys. 2010. Vol. 108. P. 083704.
- 2. R. L. Withers, J. G. Thompson, A. D. Rae // J. Solid State Chem. 1991. Vol. 94. P. 404.
- 3. A. D. Rae et al. // Acta Crystallogr. B Struct. Sci. 1992. Vol. 48. P. 418.
- 4. Ting-Shan Chan et al. // J. Mater. Chem. 2011. Vol. 21. P. 17119-17127.